

GDT Array(アレイタイプ)



用途に合わせた特殊形状



High current GDT
高圧用GDT

FEATURES :特性

- *SMDデザイン: 3端子/2端子/Arrayタイプ/各用途に合った特殊形状
- *High Current Handling Capaility:10,000A @ 8/20 μ s
- * Low Capacitance & Insertion Loss: 1.5pF以下 (1MHz)
絶縁抵抗値: 1G Ω 以下 100VDC
- * QuickResponse & Long Service Life:高速答性&長寿命
- * Moisture sensitivity level(耐湿度レベル): Level 1

APPROVALS :安全規格

UL

品番	直流放電開始電圧	許容差	インパルス放電電圧開始	インパルス放電電流耐量	絶縁抵抗		キャパシタンス(静電容量)
Part Number	DC Breakdown Voltage①	Tolerance of Vs	Impulse Spark-over Voltage 1kV/ μ s	Impulse Discharge Current②③	Insulation Resistance		Capacitance ④ (1MHz)
	100V/s				G Ω	DC	
B3D230M-CD	230V	\pm 20%	99% \leq 450V	10,000A	\geq 1	100V	\leq 1.5pF

①、The parameters of all are tested by ITU-T K12 全パラメータはITU-T K12にて試験

②、Total Impulse Discharge Current 10,000A @ 8/20 μ s by IEC 61000-4-5, 10 shots

総インパルス放電電流: 1,000A @8/20 μ s (IEC61000-4-5,10回印加)

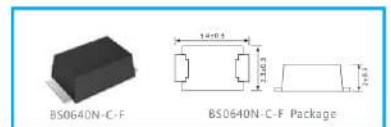
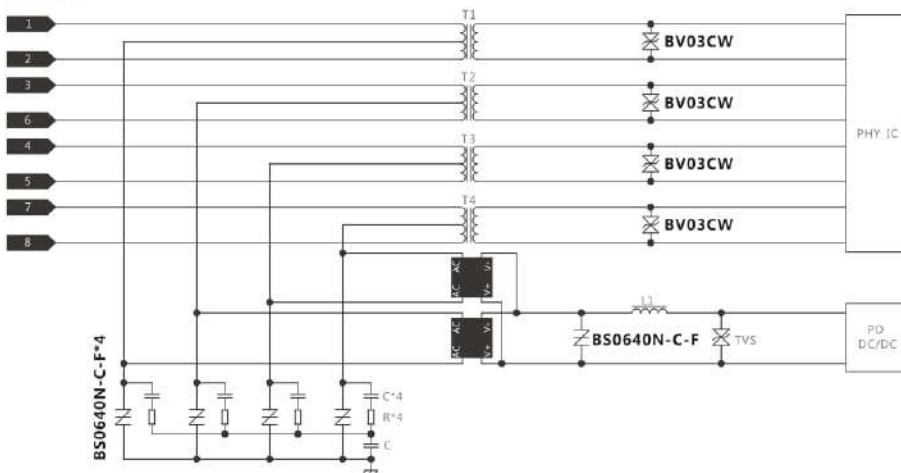
③、Currents through center electrode, half value through each line electrode インパルス放電電流がエレクトロードの中心場合は半分になります

④、The capacitance are tested by 1MHz キャパシタンス(静電容量) 測定 1MHz

Solutionの提案例

Gigabit POE For PD Side(Basic)

Solution



Advantages

- Surge level: 1, Signal Line 10/700 μ s -5/320 CM 6KV-150A DM 2KV -50A ;1.2/50 μ s CM 6KV-142.8A.
2, Power line 1.2/50 μ s -8/20 μ s DM 1KV-23.8A.
- ESD Level: Contact 8KV,Air 15KV.
- Secondary TVS has low residual voltage to protect PHY IC.
- Secondary TVS has low leakage current to solve packet loss at high temperature.